Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0214U005487

Державний реєстраційний номер: 0114U002619

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-02-2015

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Створення плівкових та періодичних надструктур із оксиду цинку та дослідження їх структурних характеристик

Початок етапу: 01.2014

Закінчення етапу: 12.2014

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02125438

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (03-244) 3-33-32, 2-15-87

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київська обл., 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380444813221

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 10

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка методики одержання тонкоплівкових фотодетекторів на основі оксиду цинку для ультрафіолетової області спектра

Назва роботи англійською:

The development of methods of obtaining of thin-film photodetectors based on ZnO for the ultraviolet region of the spectrum

Реферат українською:

Розроблено технологію отримання плівок оксиду цинку методом імпульсного лазерного осадження. Встановлено закономірності росту плівок на різних підкладках. Визначено параметри міжплощинних віддалей і ступінь монокристалічності плівок вирощених на різних підкладках. Вивчено процеси конденсації ростового матеріалу плівок оксиду цинку та побудовано статистичні характеристики морфології поверхонь.

Реферат англійською:

The technology of obtaining zinc oxide films by pulsed laser deposition. Patterns of growth of films on various substrates. The parameters of interplanar distances and the degree of crystalline of the films grown mono on various substrates. The process of condensation of the growth material zinc oxide films and built statistical characteristics of surface morphology.

Індекс УДК: 621.315.5/.6; 621.318.1; 666.65, 621.315.592

Коди тематичних рубрик: 47.09

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Вірт Ігор Степанович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Технологію отримання плівок оксиду цинку методом імпульсного лазерного осадження

Назва НТП англійською: Technology for zinc oxide films by pulsed laser deposition

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: 73.1 - Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Розроблено технологію отримання плівок оксиду цинку методом імпульсного лазерного осадження. Встановлено закономірності росту плівок на різних підкладках. Визначено параметри міжплощинних віддалей і ступінь монокристалічності плівок вирощених на різних підкладках. Вивчено процеси конденсації ростового матеріалу плівок оксиду цинку та побудовано статистичні характеристики морфології поверхонь.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2015 рік

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Науково-дослідні установи, підприємства військової та електронної промисловості

Перспективні ринки: Україна, країни ЄС

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 0

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 0

Очікуваний термін окупності (років): не визначався

Додаткова інформація: на підставі угод

IX. Бібліографічний опис

M.V. Vuichyk, Z.F. Tsybrii, S.R. Lavoryk, K.V. Svezhentsova, I.S. Virt, A. Chizhov. Morphologic and optical characterization of ZnO:Co thin films grown by PLD // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2014. V. 17, N 1. P. 80-84.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Скотна Надія Володимирівна
д. філос. н., 09.00.10

Перелік осіб-виконавців

Вірт Ігор Степанович

Павловський Юрій Вікторович

Тур Юрій Васильович

Хабінський Василь Миронович

Шпук Ольга Степанівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

